新時代へのビジョン　京の有力企業トップ7氏に聞く

不二電機工業
小西 正社長

重電機器市場を深耕
一般産業・海外向けも強化

◁ ◀ ◁

―中長期ビジョンを策定されました。

「2月にスタートした。売上高は5年後の2018年1月期に50億円、10年後の23年1月期に100億円を目指している。重電機器市場の深耕、一般産業市場の開拓、海外市場の開拓を進める。売上高目標だけでなく経常利益率も現在の約13％を以前の20％の水準まで戻すのが狙いだ」

―取り組みは。

「重電機器は接触不良を防ぐダブルブリッジ高信頼性カムスイッチや小型カムスイッチなど当社独自製品で受配電など電力市場を深耕する。伸び悩む市場だが、現在の50％からシェアアップで100％を目指す。また、電力市場向けで培った技術を生かし、絶縁電圧が直流1500㍍の遮断端子台やヒューズホルダ端子台などでメガソーラー需要をより積極的に獲得していく計画だ」

―そのほかは。

「一般産業市場では鉄道向けを強化。従来の銅合金に比べて30％軽量化を実現したアルミ端子台で置き換え需要を狙う。色覚障害者が判別できる扉開閉予告灯は新幹線『N700A』に採用された。さらに米国の地下鉄や中国の鉄道でスイッチが採用されるなど、国内外でさまざまな展開が期待できる」

―海外売上高を引き上げる計画です。

「現在の5億円を5年後に2倍の10億円とするのを目指している。中近東での電力インフラ整備需要は底堅く、落下式故障表示器など生産が追いつかないほどだ。当面は高水準の需要が続くだろう」

―みなみ草津工場が本格稼働しました。

「2月に完成し、制御用開閉器を中心に生産している。樹脂成形の内製化にと射出成形機を導入、自動化を進めてビジョン実現を支える」

ニチコン
荒木 幸彦社長

成長路線へ転換狙う
「トップノッチ戦略」掲げ

◁ ◀ ◁

―今期黒字化は必達の目標です。経営の方向性や力を入れていく分野は何ですか。

「今期は成長路線にギアチェンジし、黒字化に持って行く。そのために重点商品に関しては、市場シェア、品質、コスト面などそれぞれの分野でトップになる『トップノッチ戦略』を掲げた。アルミ電解コンデンサーやリチウムイオン蓄電池など現在トップの製品はこれを維持し、トップでないものは一定の期限内にトップを取るつもりだ。全社員が不退転の決意でやっていく」

―今後の具体的な戦略について聞かせて下さい。

「実現に向けて4月から組織を商品別に九つのビジネスグループに再編し、グループごとに営業、生産、技術開発の各部門を垂直統合した。グループ長に権限や責任を持たせ、業務の効率化につなげる」

―期待する事業は。

「今期黒字化には環境ビジネスがカギを握る。特に蓄電池が好調だ。電気自動車（EV）を家庭用の蓄電池として使うビークルツーホーム（V2H）システムや家庭用リチウムイオン蓄電池、大容量の産業用蓄電池など多彩な品ぞろえと高品質が強み。今後も製品数を拡充するほか、自動車メーカーや住宅メーカーなど納入先を増やしていく。2019年3月期に蓄電池システムで売上高800億円を目指す」

―海外事業ではアジアを重視しています。

「中国の経済成長に多少ブレーキがかかったと言われるが、まだまだ大きな市場。中国では昨年、江蘇省宿遷市にアルミ電解コンデンサーの新工場が稼働。中国で需要が急増するエアコン向けを取り込んでいく。中国に加えてマレーシアなどの生産拠点も引き続き強化する」

尾池工業
尾池 均社長

成膜技術で優位保つ
応用分野の拡大も目指す

◁ ◀ ◁

―タッチパネル向けフィルムの販売状況は。

「スマートフォンやタブレットでの採用がかなり増え、透明導電性ITO（インジウム・スズ酸化物）フィルムの販売は昨年比でかなりの上乗せとなっている。タッチパネルとカバーガラスを一体化しITOフィルムが必要ないワングラスソリューション（OGS）も注目されたが、結果的には主流にならず、ITOフィルムの需要は急速に増加している」

―市場拡大で競争は厳しさを増してます。

「ITOフィルムでも新興メーカーが多く参入している。ただ大半はドライコーティングしか対応できず、ウエットコーティングされた部材を外部から調達せざるを得ない。当社はこの両方の技術を持っており、タッチパネルメーカーの製造プロセスへの細かな対応や、カスタマイズする力で差別化できる」

―タッチパネル向けの売上比率が大きい。

「グループ内での売上比率も多くなってきており、市場シェアは20％ぐらい。ただわれわれの競争力は成膜技術にあり、タッチパネル向けだけに限らない。電子ペーパーやフィルムタイプの太陽電池、有機エレクトロルミネッセンス（EL）照明など応用分野をもっと広げる。すでに各メーカーでは評価段階にある。またチップオンフィルム（COF）によって培った技術を応用した電子部材なども有望だ」

―エレクトロニクス分野は技術進化が激しい。

「タッチパネルも将来的にどのような構造になるのかは分からない。材料が変わる可能性だってある。そのようなリスクに対応するため、事業の幅を広げるとともに、技術開発で常にリードしていくことが必要だ」

ロームのSiCパワーデバイス＆パワー半導体

Pb Free　RoHS

■SiCショットキーバリアダイオード（SiC-SBD）ラインアップ

品名	絶対最大定格 直流逆方向電圧 VR(V)	絶対最大定格 順方向電流 IF(A)	電気的特性(Ta=25℃) 順方向電圧VF(V) Typ.	順方向電圧VF(V) IF(A)	逆方向電流IR(μA) Max.	逆方向電流IR(μA) VR(V)	パッケージ
NEW SCS206AG/AM	600	6	1.35	6	120	600	TO-220AC 2L / TO-220FM 2L
NEW SCS208AG/AM	600	8	1.35	8	160	600	
NEW SCS210AG/AM	600	10	1.35	10	200	600	
NEW SCS212AG/AM	600	12	1.35	12	240	600	
NEW SCS220AG/AM	600	20	1.35	20	400	600	
NEW SCS205KG	1200	5	1.4	5	100	1200	TO-220AC 2L
NEW SCS210KG	1200	10	1.4	10	200	1200	
NEW SCS215KG	1200	15	1.4	15	300	1200	
NEW SCS220KG	1200	20	1.4	20	400	1200	
NEW SCS220AE2	600	※10/20	1.35	10	※200/400	600	TO-247
NEW SCS240AE2	600	※20/40	1.35	20	※400/800	600	
NEW SCS210KE2	1200	※5/10	1.4	5	※100/200	1200	
NEW SCS220KE2	1200	※10/20	1.4	10	※200/400	1200	
NEW SCS230KE2	1200	※15/30	1.4	15	※300/600	1200	
NEW SCS240KE2	1200	※20/40	1.4	20	※400/800	1200	

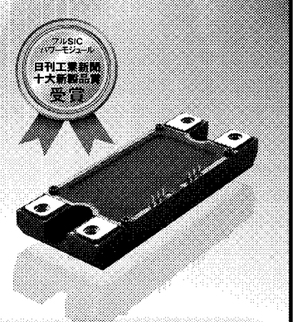
※1端子／パッケージ

業界初※SiC-MOSモジュール量産。
※:2012年12月ローム調べ

◎損失55％低減（Si-IGBTモジュール比）　◎50kHz以上の高周波動作

■"フルSiC"パワーモジュール

品名	VDSS(V)	ID(A)	ハーフブリッジ回路
NEW MOSモジュール BSM180D12P2C101	1200	180	
MOS+SBDモジュール BSM120D12P2C005	1200	120	



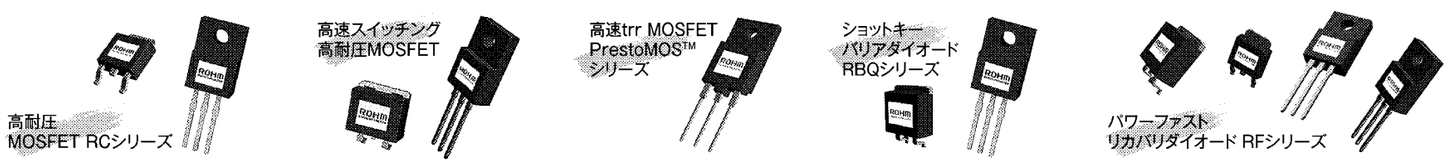
■SiC-MOSFETラインアップ

品名	BVDSS(V)	RDS(on)(mΩ)	パッケージ
SCT2080KE (SiC-MOSFET)	1200	80	TO-247
NEW SCH2080KE (SiC-MOSFET+SiC-SBD)	1200	80	TO-247

1パッケージSiC-MOSFET
Drain / Gate / Source / SiC-SBD内蔵

◎リカバリ時間が短い　◎ロスの少ない高速スイッチングが可能　◎インゴットからパワーデバイスまで一貫した製造・開発体制で高品質

Siパワー半導体も続々ラインアップ
活躍領域に合わせて進化し続ける、ロームの高性能パワーデバイス



ローム株式会社
www.rohm.co.jp
〒615-8585
京都市右京区西院溝崎町21
TEL.075-311-2121
ROHM SEMICONDUCTOR